白川(晃) 研究室

鈴木 優哉

1. 序論

招短パルスレーザーは短いパルス幅のた めに尖頭出力が高く、非熱微細加工・高エネ ルギー分野による利用を念頭に研究が行わ れている。超短パルスを生成するためには、 モード同期という手法を用いる必要があり、 共振器内を十分最適化する必要がある。し かし、高出力固体レーザーにおいて励起に より発生する熱に関する問題は共振器設計 の際にボトルネックとなることがある。こ れは熱複屈折という現象により偏光によっ て異なる光路差を持ち、利得媒質自身が寄 生的なレンズとなることに起因している。 本研究では、高出力超短パルスレーザー用 利得材料として開発された Yb:CaF₂-LaF₃ セラミックを用いて熱レンズフリー材料を 作成する試みの前段階として、屈折率の温 度係数測定法の改良と評価を試みた。

2. 熱レンズ効果

熱レンズ効果とは、媒質自身の温度分布 のために媒質自身がレンズ状の媒質となる 現象のことである。レーザーによって励起 されている利得媒質の場合、一般に温度は 二乗分布となる。このとき媒質断面での温 度分布は、極座標系における角度による依 存性がなく半径 r によって一意的に決まる 場合以下の式によって立式される[1]。

$$T(r) = T(r_0) + \left(\frac{Q}{4K}\right)(r_0^2 - r^2) \qquad (\vec{x}.\ 1)$$

光学的な屈折率変化は温度勾配と応力によって引き起こされるため、屈折率はロッド 中心の屈折率をn₀とすると

$$\mathbf{n}(r) = n_0 + \Delta n(r)_T + \Delta n(r)_{\varepsilon} \qquad (\vec{\mathbf{x}}. 2)$$

である。温度勾配による屈折率の微小変化 は

$$\Delta n(r)_T = [T(r) - T(r_0)] \left(\frac{dn}{dT}\right) \qquad (\textbf{x}. 3)$$

であり、式.3に式.1を用いると

$$\Delta n(r)_T = -\frac{Q}{4K} \left(\frac{dn}{dT}\right) r^2 \qquad (\vec{\mathbf{x}}. 4)$$

となる。この式から、 $\frac{dn}{dT} > 0$ のとき媒質は凸

レンズ状の屈折率分布となり、 $\frac{dn}{dT} < 0$ のと き媒質は凹レンズ状の屈折率分布となるこ とがわかる。

式.2に温度勾配と応力による屈折率変化の 寄与とを代入して整理すると

$$\mathbf{n}(r) = n_0 \times \tag{$\mathbf{\vec{x}}. 5)}$$

$$\left[1 - \frac{Q}{2K} \left(\frac{1}{2n_0} \frac{dn}{dT} + n_0^2 \alpha C_{r,\phi}\right) r^2\right]$$

となる。このときの屈折率分布による焦点 距離 f は

$$f' \cong \frac{K}{Ql} \left(\frac{1}{2} \frac{dn}{dT} + n_0^3 \alpha C_{r,\phi} \right)^{-1} \qquad (\vec{\mathfrak{x}}. 6)$$

となる[1]。この式は温度による屈折率変化 と光弾性効果を含んだ熱レンズ効果による 焦点距離を表している。屈折率の温度係数 が負であり、熱膨張係数が正であるような フッ化物系の材料で組成を調整可能であれ ば、これらのパラメータを適切に調整でき 熱レンズ効果を著しく低減できる可能性が 高い。

3. Yb:Ca F_2 -La F_3

本研究室では株式会社ニコンとの共同研 究として、CaF2セラミックに Yb イオンと La イオンを共添加したフッ化カルシウム-フッ化ランタン(Yb:CaF2-LaF3)セラミック の開発を行ってきた。Yb:CaF2-LaF3セラミ ックは Yb:CaF2 由来の幅広い蛍光スペクト ル[2]を継承した透明セラミック材料であ る。フーリエの関係から幅広い蛍光スペク トルの材料は、短いパルス幅をもつ超短パ ルス光源の利得材料として適している。

図 1 に実際に使用した Yb:CaF₂-LaF₃ セ ラミックを示す。



図 1 Yb:CaF₂-LaF₃セラミック試料の写真

図 1 に示すように様々な添加濃度で Yb:CaF₂-LaF₃セラミックを作成することが 可能である。

Yb:CaF₂-LaF₃セラミックは熱間等方加圧 法(Hot isostatic press, HIP 法)と呼ばれる 製法に基づいて作製されている[3]。作製し た Yb:CaF₂-LaF₃ セラミックの走査型電子 顕微鏡(SEM)画像を図 2 に示す。



図 2. Yb:CaF₂-LaF₃セラミック SEM 画像

画像のように grain 同士の境界(grain boundary)が非常に薄く、欠陥の少ない良質 なセラミックが形成されていることがわか る。セラミック中の grain の粒径はおよそ 数µmから数十µmである。

このとき CaF_2 -La F_3 は共晶系を形成して いる[4]。2 価の Yb イオンの形成を抑制す るために Yb 添加時の電荷補償の必要性か ら La F_3 は添加されている。 CaF_2 , La F_3 の成 分比を調整することで物性値を変えること が出来ると示唆されている。

4. 屈折率の温度係数測定

屈折率の温度係数の測定は、干渉計を用 いる方法がある[5]。本研究ではフィゾー干 渉計を用いた。図3に実験の構成図を示す。 試料は LD を用いて、結晶自体の吸収を利 用して加熱を行うことで結晶の光軸方向の 温度分布を小さくすることが可能である。

屈折率ⁿ、長さ^Lの試料を光が通過する 場合、試料表面と試料裏面で反射した光の 光路差^Sは次のように表される。

$$\delta = 2nL \qquad (\vec{\mathfrak{x}}.7)$$



図 3 屈折率の温度係数の測定系

試料の屈折率と長さが温度変化すること によって、式.7 で表される光路差も温度に よって変化する。光弾性効果を無視すると 関係式は式.7 より

$$\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}T} = 2L\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}T} + 2n\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}T} \qquad (\mathrm{\vec{\pi}}.\ 8)$$

両辺をL で割ると、式.8より

$$\frac{1}{L}\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}T} = 2\left(\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}T} + n\alpha\right) \qquad (\vec{\mathrm{T}}. 9)$$

となる。但し、αを熱膨張係数とし、

$$\alpha = \frac{1}{L} \frac{dL}{dT} \qquad (\textbf{\vec{x}}.10)$$

とする。試料の温度を Δ T変化させたときに 干渉縞の明暗が一周したとすると、参照光 の波長を λ とすれば、試料の光路差は $\Delta\delta$ = λ である。これより式.9より

$$\frac{dn}{dT} = \frac{1}{2L}\frac{\lambda}{\Delta T} - n\alpha \qquad (\vec{\mathrm{rt}}.11)$$

となる。式.11 より試料に温度差を加えた

ときに干渉縞のフリンジを測定することで、 屈折率の温度係数を求めることができる。

測定によって得られた干渉縞の明暗の変 化を図4に示す。干渉縞の明暗の変化は光 検出器によって測定し、試料の温度はサー ミスタを用いて測定を行った。このとき加 熱方法は中心波長965nmのLDで試料上方 斜め30度から直径10mmで励起しており、 参照光であるHe-Neレーザーは試料の端、 サーミスタ近傍に照射した。試料を加熱し ある温度からLDの電源を切り空気による 冷却により測定を行った。試料は3%La, 2%Ybで、試料の厚みは5.65mmであった。



図4干渉縞の明暗の変化(3L2Y 試料)

干渉縞の明暗が1周するときのΔTの値 は3.22℃であった。したがって式.11よ り、試料の屈折率の温度係数は以下のよう に算出できた。

.

$$\frac{dn}{dT} = -5.92 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1} \qquad (\textbf{\vec{\pi}}.12)$$

尚、このとき He-Ne レーザーの波長 λ は 632.8nm, 屈折率 n は 1.43、熱膨張係数 α は16.3 × 10⁻⁶ K⁻¹を用いた。

5. 励起加熱時の定常状態の温度分布

屈折率の温度係数測定における過渡的な 試料中の光軸方向の温度分布変化は屈折率 の温度係数測定の精度に影響し、評価する 必要がある。そのため過渡的な試料の温度 分布を熱伝導方程式より求めるために、前 段階として定常状態の温度分布を求めた。 図5に境界条件となる試料表面の温度分布 を測定するための系を示す。



図5測定した試料表面の温度分布

今回試料表面の 30nm の Au コーティン グはイオンスパッタリング法を用いて行っ た。その後温度測定のためにファインケミ カルジャパン社製のブラックガードスプレ ーFC-153 を均一に照射し C コーティング を施した。コーティング後の 3.2mm 試料 の温度分布を図 6 に示す。



(a)側面(b)照射面図 6 コーティング後の試料の温度分布

その後、それぞれ一次元的に温度分布を 取り、これらを境界条件として二次元の定 常に次元熱伝導方程式で自己発熱の寄与を 含めてシミュレーションすると、図7のよ うになる。



尚、 $\eta_s = 0.88$, 試料半径 R=6.5 mm, 吸 収係数 $\alpha = 0.6 \text{ cm}^{-1}$, 熱伝導率K = 4.0 W/ m K, ビーム半径 ω 2.85mm, l = 3.2mm,

 $E_0 = 0.395 \, \text{W}^{\frac{1}{2}} \text{mm}^{-1}$ の状態を求めた。今

後、過渡的な状況について試料の温度分布 の変化を求め、屈折率の温度係数の値の妥 当性について吟味する必要がある。

参考文献

[1] W. Koechner, (2006). *Solid-State Laser Engineering*. Springer.

[2] V. Petit j, *et al.* Appl. Phys. B **78**, 681(2004)

[3] H. Ishizawa, U.S. patent 20,140,239,228 (August 28, 2014).

[4] M. Švantner, *et al.* Cryst. Res. Technol.14, 365 (1979).

[5] V. Cardinali, *et al.* Optical Materials **34**, 990 (2012)